



FITXA IDENTIFICATIVA

DADES DE L'ASSIGNATURA

Codi: 34791
Nom: Dispositius electrònics i fotònics
Cicle: Grau
Crèdits ECTS: 6
Curs acadèmic: 2026-27

TITULACIONS

Titulació	Centre	Curs	Període
1402 - Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació	Escola Tècnica Superior d'Enginyeria	2	Primer quadrimestre

MATÈRIES

Titulació	Matèria	Caràcter
1402 - Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació	Circuits i components electrònics i fotònics	BÀSICA

COORDINACIÓ

NAVARRO ANTON ASUNCION EDITH

RESUM

Aquesta és una assignatura de Formació Bàsica, que s'imparteix en el primer quadrimestre de segon curs del Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicacions. La càrrega lectiva total és, com en la majoria de les assignatures, de 6 ECTS. La càrrega de treball per a l'estudiant és de 150 hores al llarg del quadrimestre, de les quals 60 són presencials i 90 són de treball individual.

Aquesta assignatura forma part de la matèria de Formació Bàsica ¿Circuits i Components Electrònics i Fotònics¿, i que ha d'aportar els coneixements elementals sobre els circuits i els dispositius tant electrònics com fotònics. Segons s'expressa en els continguts del mòdul dels graus en els quals s'imparteix, aquesta matèria: *"ofereix als estudiants una introducció als circuits electrònics. Es descriurà el funcionament físic i electrònic, materials que els conformen i els models circuitals dels diferents dispositius electrònics i fotònics. Així mateix s'adquiriran les nocions bàsiques de teoria de circuits i la seua aplicació als dispositius¿. També "es coneixeran els principis de la lògica digital¿. Es pretén, en aquesta matèria, ¿que els estudiants aprenguen a comprendre els circuits electrònics i els seus dispositius, sàpiguen aplicar les diferents tècniques de resolució i disseny de circuits i utilitzen els dispositius electrònics en aquests circuits ¿.*

De tots els continguts expressats en la matèria Circuits i Components Electrònics, l'assignatura Dispositius



Electrònics i Fotònics, s'encarregarà de la descripció dels dispositius des del punt de vista que abasta des de l'interior del dispositiu fins a les seues característiques macroscòpiques o de eixida, passant pels seus circuits equivalents. Per remarcar els coneixements sobre el comportament dels dispositius, es veuran al final de l'assignatura alguns circuits que utilitzen aquests dispositius.

A part dels continguts purament teòrics, l'assignatura proveirà a l'estudiant dels coneixements generals necessaris per a la resolució de problemes d'Enginyeria. Els coneixements de resolució de problemes s'adquiriran en les sessions de problemes de l'assignatura, on l'estudiant haurà de trobar la solució a problemes en els quals el plantejament requereix l'obtenció de diverses solucions prèvies al resultat final.

Sobre les habilitats que són requerides per a qualsevol enginyer, l'assignatura aporta els coneixements necessaris per al muntatge de circuits bàsics sobre plaques de laboratori. Aportant a l'estudiant les habilitats de recerca de components, interpretació d'esquemàtics de circuits, muntatge de diversos dispositius amb nodes comuns, mesures sobre els circuits amb instrumentació de laboratori, representació d'un conjunt de mesures a nivell tant de taula com de gràfica i, finalment, la interpretació d'aquestes dades una vegada obtingudes

CONEXEMENTS PREVIS

RELACIÓ AMB ALTRES ASSIGNATURES DE LA MATEIXA TITULACIÓ

No s'ha especificat restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.

ALTRES TIPUS DE REQUISITS

Els coneixements previs necessaris per seguir el curs de l'assignatura són els que s'adquireixen en les assignatures de Matemàtiques i en l'assignatura Circuits Electrònics que s'imparteixen en primer curs. Dins d'aquests coneixements cal destacar l'operació amb integrals i derivades i el reconeixement de gràfiques i l'extracció de dades a partir de les mateixes. Per a l'última part de l'assignatura són necessaris coneixements bàsics de teoria de circuits.

COMPETÈNCIES / RESULTATS D' APRENTATGE

1402 - Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

B4 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics de sistemes lineals i les funcions i les transformades relacionades, teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics i fotònics, tecnologia de materials i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

G3 - Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies que el capacite per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, així com que el dote d'una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions.



G4 - Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de telecomunicació.

G5 - Coneixements per a la realització de mesures, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs en el seu àmbit específic de la telecomunicació.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS

1. Introducció

Tema 1: Introducció als materials semiconductors. Materials semiconductors intrínsecs i dopats. Tècniques de dopat de semiconductors.

2. El díode semiconductor

Tema 2: La unió PN. La unió PN amb i sense polarització. La unió PN polaritzada. Corrents en la unió PN. La corba de característica estàtica.

Tema 3: Tipus de díodes. L'efecte de devessall. El díode Zener. El díode Schottky. Paràmetres i corbes dels diferents tipus de díodes. Fulles de característiques.

Tema 4: Utilització de díodes. Estudi dinàmic. El model de petit senyal. Exemples d'aplicació de díodes de senyal. Circuits amb díodes zener.

PRÀCTICA 1: El díode d'unió. Característica IV i les seues aplicacions. (6 hores)

3. El transistor bipolar

Tema 5: Les unions PNP i NPN sense polarització i amb polarització. Regions de funcionament depenent de la concentració de portadors minoritaris a la base. Paràmetres i corrents en funció de les característiques internes dels transistors bipolars. Paràmetres i corbes característiques dels transistors bipolars.

Tema 6: Fulles de característiques dels transistors bipolars.

Tema 7: Utilització de transistors bipolars. Estudi dinàmic. El model de petit senyal. Exemples d'aplicació de transistors bipolars.

PRÀCTICA 2: Obtenció experimental de les corbes característiques del BJT en la configuració d'emissor comú. (3 hores)



4. El transistor unipolar

Tema 8: Estructura interna dels transistors unipolars. El transistor MOSFET. Regions de funcionament i corrents dels transistors unipolars en funció de les seues característiques internes. Corbes i paràmetres característics dels transistors unipolars.

Tema 9: Fulles de característiques de transistors unipolars.

Tema 10: Utilització de transistors unipolars. Estudi dinàmic. El model de menuda senyal. Exemples d'aplicació de transistors unipolars.

PRÀCTICA 3: El transistor MOSFET. (3 hores)

PRÀCTICA 4: El transistor bipolar i el unipolar en conmutació: comparativa. (3 hores)

5. Famílies i portes lògiques

Tema 11: Famílies i portes lògiques. Portes lògiques bàsiques.

PRÀCTICA 5: Portes lògiques. (3 hores)

6. Dispositius fotònics

Tema 12: Dispositius sensibles a la llum. Fotoresistències. Fotodíodes. Fototransistors. Dispositius emissors de llum. El LED.

PRÀCTICA 6: Fotoresistències, leds i cèl·lules solars: aplicacions. (3 hores)

PRÀCTICA 7: PROVA INDIVIDUAL (2 hores)

VOLUM DE TREBALL (HORES)

ACTIVITATS PRESENCIALS

Activitat	Hores
Teoria	30,00
Pràctiques a l'aula	10,00
Laboratori	20,00
Total hores	60,00

ACTIVITATS NO PRESENCIALS

Activitat	Hores
Assistència a altres activitats	1,00
Elaboració de treballs individuals o en grup	0,00
Estudi i treball autònom	0,00
Preparació de classes	39,00
Preparació d'activitats d'avaluació	50,00
Resolució de casos pràctics	0,00
Total hores	90,00



METODOLOGIA DOCENT

CLASSES DE TEORIA.

Les classes de teoria s'impartiran de manera magistral, realitzant el professor les preguntes pertinents prèvies a la classe per determinar el nivell de coneixements que han adquirit els estudiants en el treball previ de preparació de cadascun dels temes. El desenvolupament de la classe es realitzarà mitjançant transparències amb les animacions pertinents per obtenir una millor comprensió dels conceptes abstractes entorn de les unions dels dispositius. L'estudiant tindrà accés al material docent relacionat amb els continguts de l'assignatura (transparències, articles, adreces web, referències per a ampliació, etc.), a través de l'Aula Virtual, una aplicació desenvolupada per la Universitat de València que facilita l'accés d'una manera fàcil i guiada a diferents tipus de recursos docents i/o administratius. Es treballen les competències G3 i B4.

CLASSES DE PROBLEMES.

Les classes de problemes s'impartiran a l'aula de teoria, però amb un grup més reduït d'estudiants. En les classes de problemes es realitzarà la resolució d'alguns dels problemes més significatius que figuren en els butlletins de problemes de l'assignatura. Els problemes es realitzaran en la pissarra i podrà ser tant pel professor com per qualsevol dels estudiants que assistisquen a aquesta classe. Igual que per a les classes de teoria l'estudiant tindrà accés a tot el material docent de problemes a l'Aula Virtual. Es treballen les competències G4 i B4.

CLASSES DE LABORATORI.

Les classes de laboratori s'impartiran en els laboratoris del Centre. Durant la primera mitja hora de la classe de laboratori el professor avaluarà alguns o a tots els estudiants sobre el coneixement de la pràctica que es va a realitzar. Aquesta avaluació es podrà dur a terme per mitjà de qüestions curtes de durada inferior a 15 minuts o per mitjà de preguntes individuals als estudiants per al cas dels grups que siguen menys nombrosos. En algun cas el professor podrà demanar treballs de simulació, mitjançant programes de simulació per ordinador, d'algun o varis dels muntatges de la pràctica que es va a realitzar. Es treballen les competències G3, G4, G5 i B4.

TUTORIES

Els estudiants disposaran d'un horari de tutories la finalitat de les quals és la de resoldre problemes, dubtes, orientació en treballs, etc. L'horari d'aquestes tutories s'indicarà a l'inici del curs acadèmic. Es



treballen les competències G3, G4, G5 i B4.

ci del curs acadèmic. Es treballen les competències G3, G4, G5 i B4.

AVALUACIÓ

AVALUACIÓ DE LA PART DE TEORIA-PROBLEMES.

La part de teoria-problemes es pot superar per dos mètodes, o bé avaluació contínua o bé examen al final del quadrimestre.

- Sistema d'avaluació contínua.

Al final de cada unitat temàtica es farà un examen tipus test amb preguntes només de teoria. De manera que tindrem exàmens tipus test amb un pes total del 60%. La nota de cada test se sumará al següent sense més per a calcular la nota final. No es fan recuperacions dels test. De manera que el dia de la convocatòria oficial de l'assignatura el que haja triat avaluació contínua només s'examinarà dels problemes dels distints temes. Eixe examen tindrà un pes del 40% sobre la nota total. (G3,G4, G5 i B4).

Hi haurà un parcial de problemes (només díodes) en acabar la primera unitat temàtica d'una hora de durada. Si la nota en aquest parcial és superior a 5, es sumaran a la nota final de l'examen de problemes (que es realitzarà en la data oficial de la convocatòria), fins a 2 punts si la nota obtinguda en l'examen final és superior a 4 punts. (G3, G4, G5 y B4)

Per a poder fer el promig entre teoria (test) i problemes cal tindre com a mínim un 5 en teoria (test) i un 5 en problemes.

El que suspenga en primera convocatòria pel mètode d'avaluació contínua els test realitzats durant l'any passaran a valdre el 25% en segona convocatòria (sempre que la nota mitjana de tots els test siga major que 3, si no haurà d'anar a segona convocatòria com a avaluació única) i l'examen de problemes passarà a valdre el 75%.

- Sistema d'avaluació única.

Constarà d'un examen final que tindrà lloc al final del quadrimestre. Aquest examen final consistirà en la realització d'una única prova subdividida en dos, una part d'activitats teòric-pràctiques i una part de problemes. (G3, G4, G5 y B4)

El que trie avaluació única, tant en primera com en segona convocatòria, haurà de tindre un 5 en cada part per a poder fer el promig entre teoria i problemes.



L'estudiant que opte des de principi de curs pel sistema d'avaluació única haurà de comunicar-ho **personalment** al professor responsable de l'assignatura.

AVALUACIÓ DE LA PART DE LABORATORI.

L'avaluació de la part de laboratori es realitzarà igual que la de la part de teoria-problemes mitjançant dos mètodes, l'avaluació contínua i l'examen final de laboratori.

- Sistema d'avaluació contínua. L'avaluació contínua es realitzarà amb l'assistència a totes les classes de laboratori i la nota resultant serà la mitjana de la prova final individual de laboratori amb l'avaluació contínua al llarg de les pràctiques. Per aprobar la part de laboratori per avaluació contínua és obligatòria l'assistència a totes les sessions de laboratori. L'avaluació contínua durant el curs es realitzarà tenint en compte la nota obtinguda en la resolució dels guions de laboratori i la nota obtinguda en les qüestions que prepare el professor prèvies a la resolució de la pràctica (amb un pes del 35% i del 15% respectivament). Aquesta nota de l'avaluació contínua constituirà el 50% de la nota de laboratori, i l'altre 50% serà la nota obtinguda en la prova individual realitzada en el laboratori l'última sessió de pràctiques. La nota d'este examen ha de ser superior a 4 per a poder fer la mitjana. (G3, G4, G5 y B4)
- Sistema d'avaluació única: examen final. Consta d'un examen final de laboratori el mateix dia que l'examen final de teoria-problemes (G3, G4, G5 y B4). S'hauran a més de lliurar resoltos tots els treballs que el professor demane a l'estudiant que haja mostrat, **amb suficient antelació**, el seu interès per aquest mètode d'avaluació. (G3, G4, G5 y B4)

Per a poder superar l'avaluació de laboratori mitjançant avaluació contínua s'hauran d'obtenir notes superiors a cinc en (n-1) de les sessions i en (n-1) de les avaluacions que realitze el professor prèvies a la realització de la pràctica. Sent n el nombre total de pràctiques/prèvies realitzades.

L'estudiant que haja optat des de principi de curs per avaluació contínua i no haja superat l'avaluació del laboratori, haurà de fer l'examen final de laboratori el dia de la convocatòria oficial. La nota d'este examen serà la nota que li corresponga com a laboratori si la mitjana de les pràctiques i prèvies es menor de 5.

L'estudiant que opte des de principi de curs pel sistema d'avaluació única deurà comunicar-ho personalment al professor responsable de l'assignatura.



AVALUACIÓ DE L'ASSIGNATURA.

La nota de teoria-problemes constituirà un 70% i la nota de laboratori un 30% en la nota final, sent imprescindible aprovar ambdues parts.

A continuació es detalla la composició de la qualificació final de l'assignatura tant per al sistema d'avaluació contínua com pel de avaluación única.

Sistema d'Avaluació Contínua

Per a poder fer el promig entre teoria (test) i problemes cal tindre com a mínim un 5 en teoria (test) i un 5 en problemes.

La nota de la prova individual de laboratori ha de ser superior a 4 per a poder fer la mitjana amb la resta d'apartats.

L'estudiant que haja optat des de principi de curs per avaluació contínua i no haja superat l'avaluació del laboratori, haurà de fer l'examen final de laboratori el dia de la convocatòria oficial. La nota d'este examen serà la nota que li corresponga com a laboratori si la mitjana de les pràctiques i prèvies es menor de 5.

L'estudiant que opte des de principi de curs pel sistema d'avaluació única deurà comunicar-ho personalment al professor responsable de l'assignatura.

Sistema d'Avaluació Única

L'examen constarà d'una part d'activitats teòric-pràctiques i d'una part de problemes, sent necessari haver aprovat ambdues parts per a superar aquest examen.

En qualsevol cas, el sistema d'avaluació es regirà per l'establert en el Reglament de Avaluació i Qualificació de la Universitat de València per a Graus i Màsters

(<https://webges.uv.es/uvTaeWeb/MuestraInformacionEdictoPublicoFrontAction.do?accion=inicio&idEdictoSeleccionado=5639>).





- Referencia c2: "Fundamentos de semiconductores". Robert F. Pierret. Ed. Addison-Wesley Iberoamericana 1994, ISBN 0-201-60144-3.
- Referencia c3: "El diodo PN de union". Gerold W. Neudeck. Ed. Addison-Wesley Iberoamericana 1993, ISBN 0-201-60142-7.
- Referencia c4: "El transistor bipolar de unión". Gerold W. Neudeck. Ed. Addison-Wesley Iberoamericana 1994, ISBN 0-201-60143-5.
- Referencia c5: "Dispositivos de efecto de campo". Robert F. Pierret. Ed. Addison-Wesley Iberoamericana 1994, ISBN 0-201-60141-9.
- Referencia c6: "Introduction to microelectronic fabrication". Richard C. Jaeger. Ed. Addison-Wesley Publishing Company 1998, ISBN 0-201-14695-9.
- Referencia c7: "Optoelectronics. An Introduction to Materials and Devices". Jasprit Singh. Ed. McGraw-Hill Companies, Inc. 1996, 1ª edición, ISBN 0-07-057650-5.
- Referencia c8: "Fundamentos de microelectrónica, nanoelectrónica y fotónica". J.M. Abella Martín, J.M. Martínez-Duart, F. Agulló-Rueda. Ed. Prentice-Hall-Pearson Education. 2005, 1ª edición, ISBN 84 205 4651-8.